

Praktikos temos (IV k. Fizika; Elektronika ir telekomunikacijų technologijos, Aukštųjų technologijos, Šviesos technologijos)

Eil. Nr.	Vadovas (vadovo el. p., darbo tel. nr.)	Temos pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis)	Trumpas temos aprašymas (lietuvių kalba ir anglų kalba)	Tema laisva/užimta
	Vitalij Kovalevskij vitalij.kovalevskij@ftmc.lt 607-22389	Medžiagų struktūrinė analizė panaudojant jonų pluošteliu Materials structural analysis using ion beams	PIXE ir RBS metodų panaudojimas medžiagų analizei. Application of PIXE and RBS methods for materials structural analysis	
	Vitalij Kovalevskij vitalij.kovalevskij@ftmc.lt 607-22389	Medžiagų savybių modifikacija panaudojant aukštos energijos jonų pluošteliu. Materials properties modification using high energy ion beams	Jonų implantavimo metodų taikymas puslaidininkinių struktūrų savybių optimizavimui. Application of ion implantations methods for the complex semiconductor structures properties optimization.	

Mokslo tiriamasis darbas II (I k. Cheminė fizika; Elektronika ir telekomunikacijų technologijos, Fotonika ir nanotechnologijos (pasirenkamas), Lazerinė fizika ir optinės technologijos, Lazerinė technologija)

Eil. Nr.	Vadovas (vadovo el. p., darbo tel. nr.)	Temos pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis)	Trumpas temos aprašymas (lietuvių kalba ir anglų kalba)	Tema laisva/užimta
	Vitalij Kovalevskij vitalij.kovalevskij@ftmc.lt 607-22389	Medžiagų struktūrinė analizė panaudojant jonų pluošteliu Materials structural analysis using ion beams	PIXE ir RBS metodų panaudojimas medžiagų analizei. Application of PIXE and RBS methods for materials structural analysis	
	Vitalij Kovalevskij vitalij.kovalevskij@ftmc.lt 607-22389	Medžiagų savybių modifikacija panaudojant aukštos energijos jonų pluošteliu. Materials properties modification using high energy ion beams	Jonų implantavimo metodų taikymas puslaidininkinių struktūrų savybių optimizavimui. Application of ion implantations methods for the complex semiconductor structures properties optimization.	

	@ftmc.lt 607-22389	modifikacija panaudojat aukštos energijos jonų pluošteliu. Materials properties modification using high energy ion beams	struktūrų savybių optimizavimui. Application of ion implantations methods for the complex semiconductor structures properties optimization.	

Mokslo tiriamasis darbas I (Ik. Teorinė fizika ir astrofizika)

Eil. Nr.	Vadovas (vadovo el. p., darbo tel. nr.)	Temos pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis)	Trumpas temos aprašymas (lietuvių kalba ir anglų kalba)	Tema laisva/užimta

Mokslo tiriamasis darbas III (Ilk. Teorinė fizika ir astrofizika)

Eil. Nr.	Vadovas (vadovo el. p., darbo tel. nr.)	Temos pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis)	Trumpas temos aprašymas (lietuvių kalba ir anglų kalba)	Tema laisva/užimta